

公益社団法人 化学工学会 反応工学部会 CVD 反応分科会主催

第 19 回シンポジウム「薄膜成長における構造形成と機能制御」

共催 CVD 研究会

主催：公益社団法人 化学工学会 反応工学部会 CVD 反応分科会

共催：CVD 研究会

日時：2013 年 5 月 29 日(水) 13:00～18:00 (終了後、懇親会を開催します。)

会場：東京大学武田ホール http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_16_j.html

参加費：化学工学会 CVD 反応分科会法人会員 (無料), 化学工学会 CVD 反応分科会個人会員 (2,000 円), 化学工学会反応工学部会会員 (3,000 円), 化学工学会会員 (4,000 円), 学生 (無料), CVD 研究会会員 (4,000 円), 非会員 (10,000 円)

申込方法：「Web 参加登録ページ」より必要事項を記入してお申込み下さい。

https://docs.google.com/forms/d/1S7iHlsoIJJjnkIY3xk3MFEF7soQFMW_pIzXnshhjKCM/viewform

上記サイトにアクセスできない場合には、(1)氏名、(2)勤務先、(3)連絡先 E-mail、(4)参加資格 (所属学会等)、(5)懇親会出欠を明記の上、電子メールにて cvd@scej.org までお申込み下さい。

申込締切：2013 年 5 月 28 日 (火) 定員 (150 名) になり次第締切ます。

開催趣旨

薄膜を形成するにあたっては、結晶・非結晶の他に結晶多形、配向、微細構造などの選択・設計が必要であり、その種類と組合せは物質、用途により様々です。そこで、物質としてシリコン、ダイヤモンド、炭化珪素、構造として結晶性薄膜を対象とした様々な手法として、熱、プラズマ、エアロゾル、などを活用した CVD 技術、について学術・産業において先端分野で活躍されている講師をお招きして、薄膜において原子・分子が縦横に規則的に配列・配向された構造の形成と機能制御などについて議論を深めたいと考えます。多数のご参加をお待ち申し上げます。

プログラム

12:30 参加受付開始

13:00～13:05 開会あいさつ

13:05～14:00 基調講演「エピタキシャル成長における構造・機能制御」

西永 頌 氏 (東京大学名誉教授)

14:00～14:40 「グラフェンのエピタキシャル CVD 成長とその展開」

吾郷 浩樹 氏 (九州大先導物質化学研究所)

14:40～15:00 休憩

15:00～15:40 「メゾプラズマ CVD によるナノクラスター支援高速エピタキシャル成長」

神原 淳 氏 (東京大学)

15:40～16:20 「AD (エアロゾルデポジション) 法による常温衝撃固化現象と

実用化への取り組み」

明渡 純 氏 (産業技術総合研究所)

16:20～16:40 休憩

16:40～17:20 「ダイヤモンド薄膜形成技術」 井上 英男 氏 (コーンズテクノロジー)

17:20～18:00 「パワー半導体用 SiC エピタキシャルウェハの生産技術開発」

百瀬 賢治 氏 (昭和電工)

18:00～19:30 懇親会 会費一般：2,000 円，学生：1,000 円

問い合わせ先

化学工学会反応工学部会 CVD 反応分科会 cvd@scej.org

シンポジウムオーガナイザー

横浜国立大学 羽深 等

アイクストロン株式会社 三宅 雅人

東京工業大学 森 伸介

会場（東京大学武田先端知ビル）案内図



交通機関

東京メトロ：千代田線・根津駅・徒歩 5 分，南北線・東大前・徒歩 1 2 分

都営地下鉄：三田線・大江戸線・春日駅 徒歩 2 0 分